П	Формат	Зона	1703.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
Перв. примен.					<u>Документация</u>		
	A2			СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07 СБ	Сборочный чертеж		
\parallel				СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07 Э1	Схема электрическая структурная		
zB. No	A3			СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07 Э2	Схема электрическая		
диј	A2			СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07 ЭЗ	Функциональная Схема электрическая		
Ш					ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ		
	A4			СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07 ПЭЗ	Перечень элементов		
и дата					<u>Детали</u>		
Подп. ц	A3		1	СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07	Плата печатная	1	
ю дубл.			2		Конденсаторы 0805–X7R–50 B–0,1 мкФ±10%	18	
NHB. N						\vdash	C13C18
Вэам. инв. №			3		0805-X7R-50 B-1000 nФ±10%		[28] [26]
дата В.			<i>4 5</i>		0805-X7R-50 B-2200 πΦ±10% 1206-X5R-10 B-47 мкФ±20%	1	C27 C29
Подп. и б	Изі	<u> </u> 		№ докум. Подп. Дата	I 1ЭИ КР ПЭ2-18 11.03	[] 3.04	07
Инв. № подл.	Ра. Пра	3paò ob. roнт,	? // 	Тавловская В.А	BOU abmomam	<i>Лист</i> 1	Листов З
ш	ווע	u.		Копиров		МДП	A4

Формат	Зана	/lo3.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
)		6		TECAP-A-50 B-1 MKΦ±10%	8	<u> </u>
		U		TLCAF-A-JU D-T MK Ψ±10 /o	0	C 1C4,C 12
						<i>C25</i>
				Микросхемы		
		7		533/IH1 (401.14-5)	1	DD2
		8		74HC40510 (TSOP-16)	3	<i>DD3,DD5</i>
				100001 (0015 011		<i>DD7</i>
		9		AD7824 (SOIC-24)	1	DA3
		10		AD8561 (SOIC-8)	2	DA6,DA7
		11		INA 118E_BB (SOIC-8)	2	DA4,DA5
		12		MC74ACTO8DG (SOIC-14)	3	<i>DD1,DD4</i>
		42		00 1 V222 (COT, 02)		<i>DD6</i>
		13		OPAX333 (SOT-23)	2	DA1,DA2
				Резисторы		
╁		14		7 ЕЗИСТИОРЫ 0805-0.125 ВП-0 ОМ ±1%	1	R23
		<i>15</i>		0805-0.125 Bm-4.7 Om ±1%	1	R5
		16		0805-0.125 BM-4.7 0H ±178	1	R18
		<i>17</i>		0805-0.125 Bm-200 0m ±1%	1	R2
\vdash		18		0805-0.125 BM-330 OM ±1%		R7
		19		0805-0.125 Bm-470 0m ±1%	1	R3
		20		0805-0.125 Bm-1 k0m ±1%	1	R16
\vdash		21		0805-0.125 Вт-1.5 кОм ±1%	1	R10
		22		0805-0.125 Вт-2 кОм ±1%	1	R6,R9
		23		0805-0.125 Вт-2.2 кОм ±1%	1	R17
\prod		24		0805-0.125 Bm-3 k0m ±1%	1	R1
		25		0805-0.125 Вт-7.5 кОм ±1%	1	R15
		26		0805-0.125 Вт-8.2 кОм ±1%	1	R11
		27		0805-0.125 Вт-10 кОм ±1%	6	R4,R8
					_	R19R22
		28		0805-0.125 Вт-51 кОм ±1%	1	R14
			$\Gamma \phi M_{7}$	И КР ПЭ2-18 11.03.С	74 <i>[</i>	$07^{\frac{\Lambda_{UCII}}{2}}$
Изм	! /IUC	ТП	№ дакум. Подп. Дата Копиров		Mam	A4 2

Взам. инв. №

Подп. и дата

Формат Зана	<i>Поз.</i>	Обозначение	Наименование	иоу	Приме- чание
	20		0005 0405 0 460 0 404	1	D42
_	29		0805-0.125 Bm-160 k0m ±1%		R13
	30		0805-0.125 Вт-200 кОм ±1%	1	R12
			Соединения контактные		
	31		CI1102M1H	2	XS2,XS
	32		C/1103M1H	1	!
	33		C11104M1H	1	XS4
	34		C11110M1H	1	XS1
			Транзисторы		
	35		NTF2955T1G	1	VT2
	36		SI2304DDS-TI-GE3	1	VT1
	<i>37</i>		Устройство коммутационное	4	SB1SE
			1T-1187USMD	,	02 ,,,,02
+					
+					
+					
+			<u> </u> ΜΟΙΑ ΙΖΩ ΠΟΟ 10 11ΩΟ ($\frac{1}{07}$
Изм. /11.	ист N° до.	кум. Подп. Дата	МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.0 опировал Форл		// -